## ПЕРЕСТРОЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МОНОКРИСТАЛЛА АЛМАЗА ПОД ПЛЕНКОЙ МОЛИБДЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ НАГРЕВА В ВЫСОКОМ ВАКУУМЕ

## <u>Седельникова О.В.</u>, Окотруб А.В., Городецкий Д.В., Асанов И.П., Федоренко А., Гурова О.А.

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия

Благодаря рекордно высокой теплопроводности, высокому напряжению пробоя и радиационной стойкости, алмаз выгодно выделяется среди широкозонных полупроводников в качестве альтернативы кремнию для применений в вычислительной и силовой электронике. Среди углеродных компаньонов к алмазу ярко смотрится графен. Объединение алмаза и графена позволяет получить новый материал, который кроме преимуществ каждого из компонентов будет иметь низкобарьерный электрический и тепловой интерфейс.

В данной работе изучена перестройка поверхности граней {100} и {111} монокристаллического алмаза в результате отжига под пленкой молибдена. Для неанесения металлической плёнки использовался метод магнетронного напыления. Исследование методом атомно-силовой микроскопии в полуконтактном режиме (микроскоп Solver-Pro) показало, что напыление металла делает поверхность более шероховатой. Образцы нагревались в высоком вакууме (10<sup>-10</sup> мбар) в камере лабораторного спектрометра SPECS FlexPS. После 20 минут отжига при заданной температуре (500 или 800°С) были измерены рентгеновские фотоэлектронные спектры углерода (C1s) и молибдена (Mo3d) без вынесения из зоны высокого вакуума. Показано восстановление оксида молибдена до металлического молибдена после отжига при 500°С и образование карбида молибдена. Нагревание до 800°С приводит к образованию графитопобных слоев на поверхностях грани алмаза {100} и молибденовых частиц, образованных при растрескивании нанесенной металлической пленки в результате отжига. Для алмазной грани {111} найдено формирование графитопобных слоев под пленкой молибдена.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-72-10097, https://rscf.ru/project/22-72-10097/